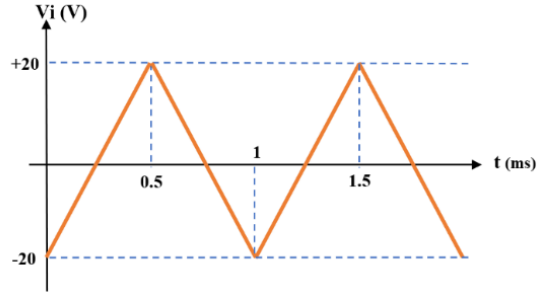
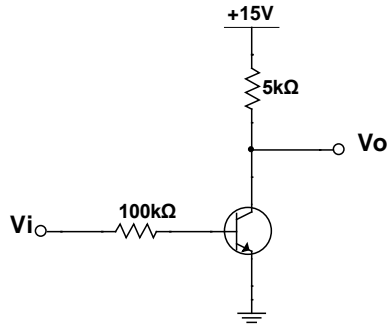
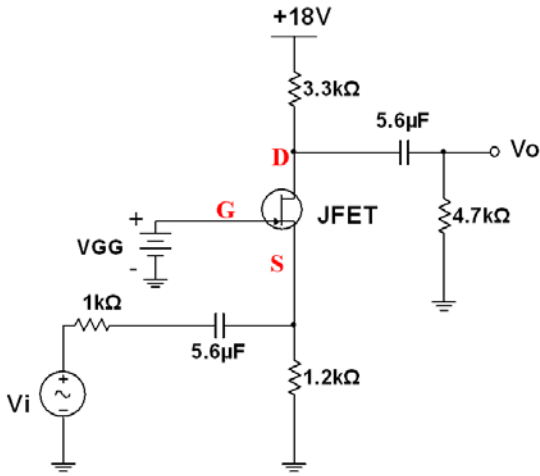


1)

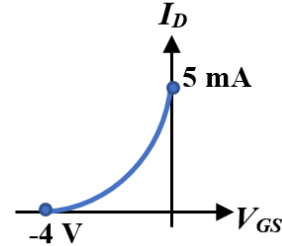


V_i ve V_o işaretlerini alt alta ölçekli olarak çiziniz.
($\beta=100$ $V_{BE}=0,7$ V
 $V_{CEd}=0,2$ V)

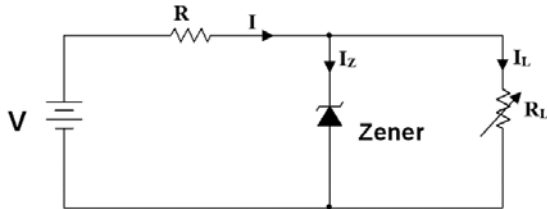
2)



- $V_{GG}=0$ için JFET' in DC çalışma noktasını bulunuz.
- $V_{GG}=0$ için V_G , V_S , V_D gerilimlerini hesaplayınız.
- JFET' i tıkmaya(kesime) sokacak olan V_{GG} değerini bulunuz.



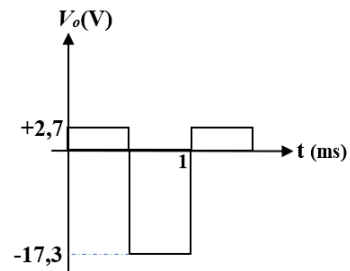
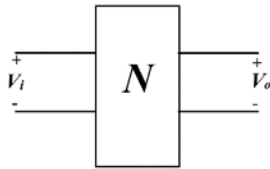
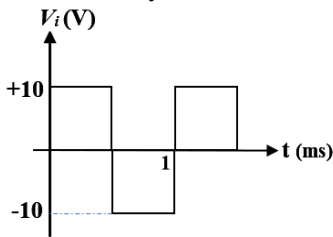
3)



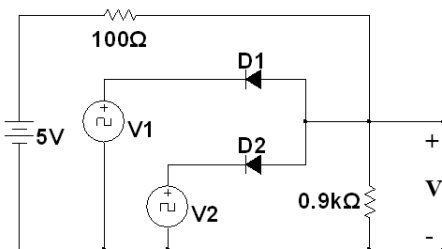
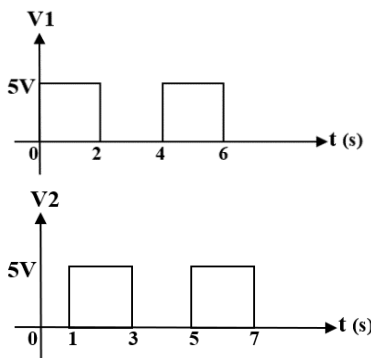
$R=1$ k Ω $V=50$ V $I_{Zmax}=32$ mA $I_{Zmin}=0$ mA olarak verilmiştir.

- Yük üzerindeki gerilimi 10 V' ta sabit tutacak R_L ve I_L değerleri nelerdir?
- Zener diyodun çekeceği maksimum gücü bulunuz.

4) V_i ve V_o işaretleri aşağıdaki gibi verilen N devresini tasarlayınız. (Eğer diyot kullanacaksanız Silisyum, $V_a=0,7$ V olan diyot kullanılmalıdır.)



5)



$D1$ ve $D2$ ideal olup $V_{a1}=V_{a2}=0,7$ V olup $V1$ ve $V2$ gerilimlerinin değişimi yandaki gibidir. Buna göre devrenin çıkışı V_o ' ı ölçekli olarak çiziniz.